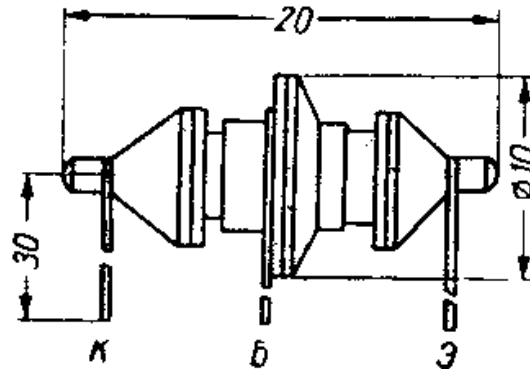


П1А, П1Б, П1В, П1Г, П1Д, П1Е, П1Ж, П1И

Германиевые усилительные низкочастотные сплавные р-п-р транзисторы. Выпускаются в металлическом патроне со стеклянными изоляторами.

Транзистор П1Д проверяется на собственные шумы и является малошумящим. Транзисторы П1И и П1Ж предназначены для работы на повышенных частотах.



Номинальные электрические данные

Коэффициент передачи тока в схеме с общей базой

П1А	$> 0,9$ (0,9...0,93)*
П1Б, П1В	0,93...0,97
П1Г, П1И	$> 0,96$ (0,96...0,99)*
П1Д, П1Е	$> 0,94$ (0,94...0,99)*
П1Ж	$> 0,95$ (0,96...0,99)*

Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общей базой

П1А – П1Д, на частоте 0,1 МГц	0,7
П1Е, на частоте 0,465 МГц	0,7
П1Ж, на частоте 1,0 МГц	0,7
П1И, на частоте 1,6 МГц	1,5

Граничная частота в схеме с общим эмиттером по уровню 0,707

П1А	150...300 кГц*
П1Б, П1В	100...400 кГц*
П1Г, П1Д	200...400 кГц*
П1Е	500...1000 кГц*
П1Ж	1000...1600 кГц*

Коэффициент усиления по мощности

П1А, П1Е, П1И	> 30 дБ
П1Б, П1Д	> 33 дБ
П1В, П1Г	> 37 дБ
П1Ж	> 35 дБ

Сопротивление базы

П1А	300...200 Ом*
П1Б, П1В	< 400 Ом (100...250 Ом)*
П1Г, П1Д	< 600 Ом (100...400 Ом)*
П1Е	< 1000 Ом (150...350 Ом)*
П1Ж, П1И	< 1200 Ом (250...1200 Ом)*

Сопротивление коллектора

П1А	$> 0,3$ МОм (0,3...3,0 МОм)*
П1Б	0,5...1,2 МОм
П1В	$> 1,0$ МОм (1,2...4,5 МОм)*
П1Г	$> 0,5$ МОм (0,7...4,5 МОм)*
П1Д, П1И	$> 0,5$ МОм (1,2...4,5 МОм)*
П1Е, П1Ж	$> 0,3$ МОм (0,3...4,5 МОм)*

Обратный ток коллектора при $U_k = 10$ В

П1А, П1Б, П1Г, П1Е	< 30 мкА
П1В, П1Д	< 15 мкА
П1Ж, П1И	< 20 мкА

Емкость коллектора

П1А, П1Б, П1В, П1Г, П1Д	20...35 пФ*
П1Е	< 60 пФ (20...35 пФ)*
П1Ж	< 40 пФ (20...35 пФ)*
П1И	< 35 пФ

* результат испытаний партий кристаллов выпуска первой половины 1956г.

Коэффициент шума

П1Б, П1В, П1Е, П1Ж, П1И
П1Д

< 35 дБ
< 18 дБ

Предельно допустимые электрические величины

Ток коллектора	5 мА
Ток эмиттера	5 мА
Напряжение на коллекторе в пике	20 В
Наибольшая рассеиваемая мощность	80 мВт (ранние выпуски – 50 мВт)
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-60 ... +50 °С

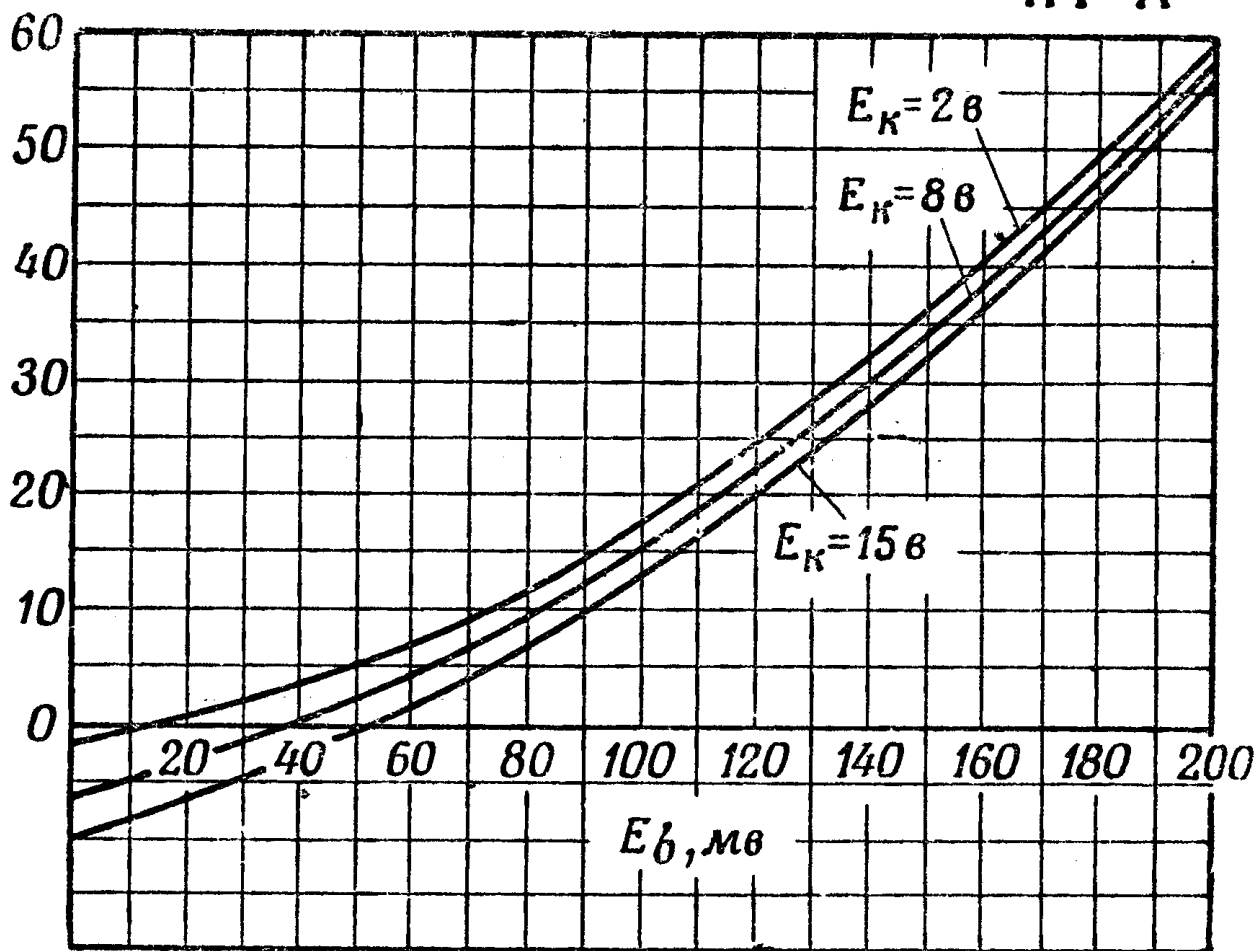
Рекомендации по применению

При включении транзистора в цепь базовый контакт должен присоединяться первым. Не рекомендуется располагать транзисторы вблизи нагревающихся элементов схемы. Пайка и изгиб выводов допускаются на расстоянии не менее 10 мм от корпуса транзистора. Паять припоем с температурой плавления не выше 150 °С.

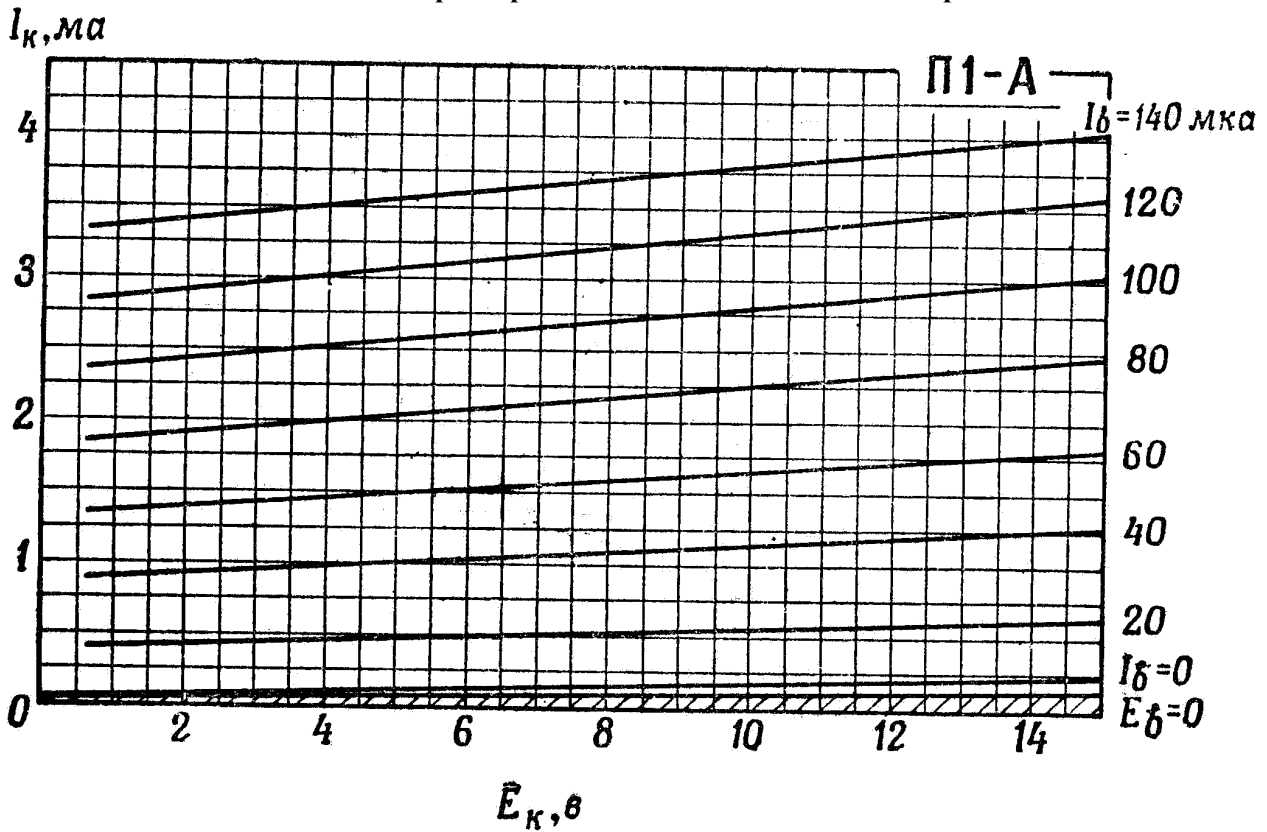
Входные характеристики в схеме с общим эмиттером

$I_b, \text{мкА}$

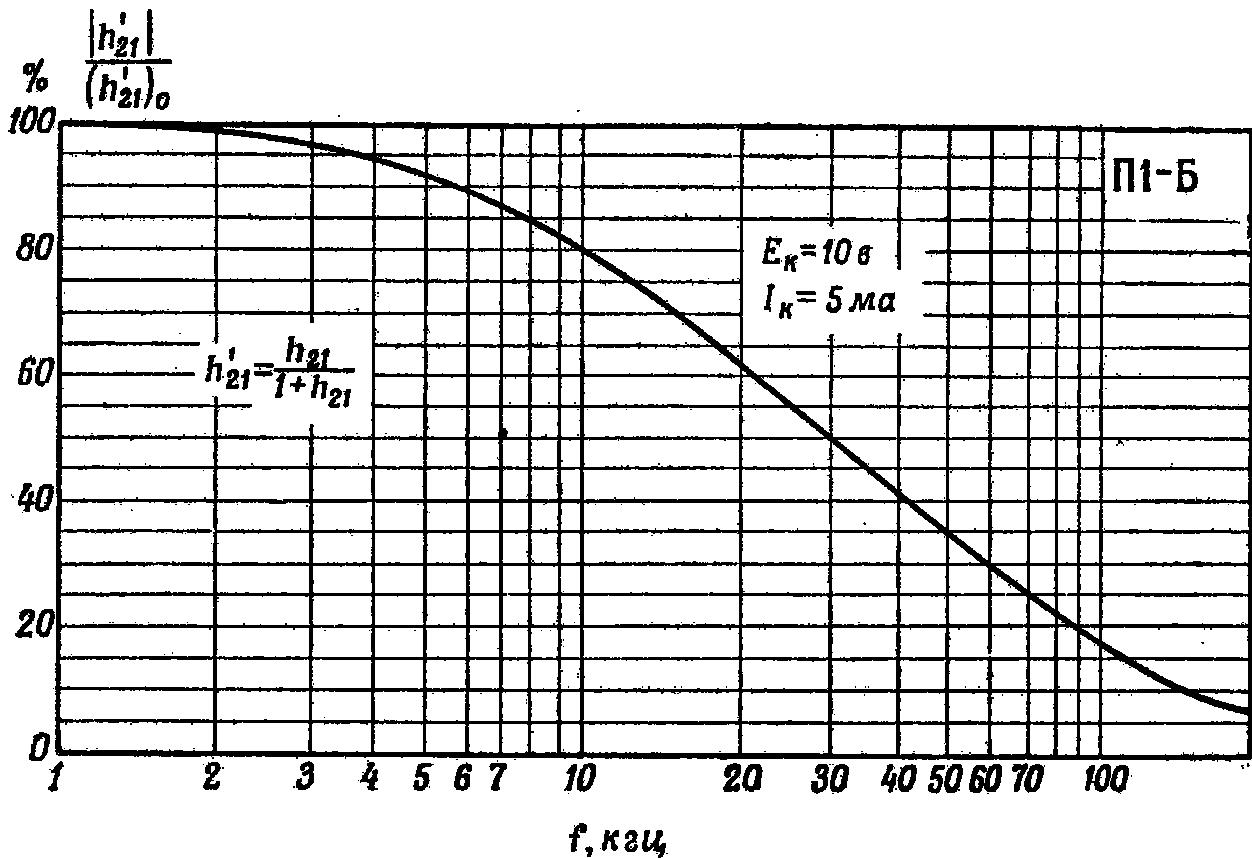
П1-А



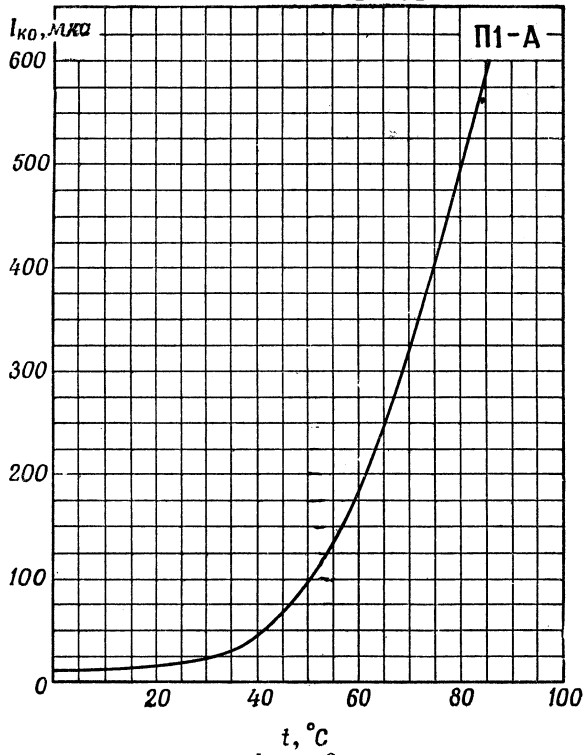
Выходные характеристики в схеме с общим эмиттером



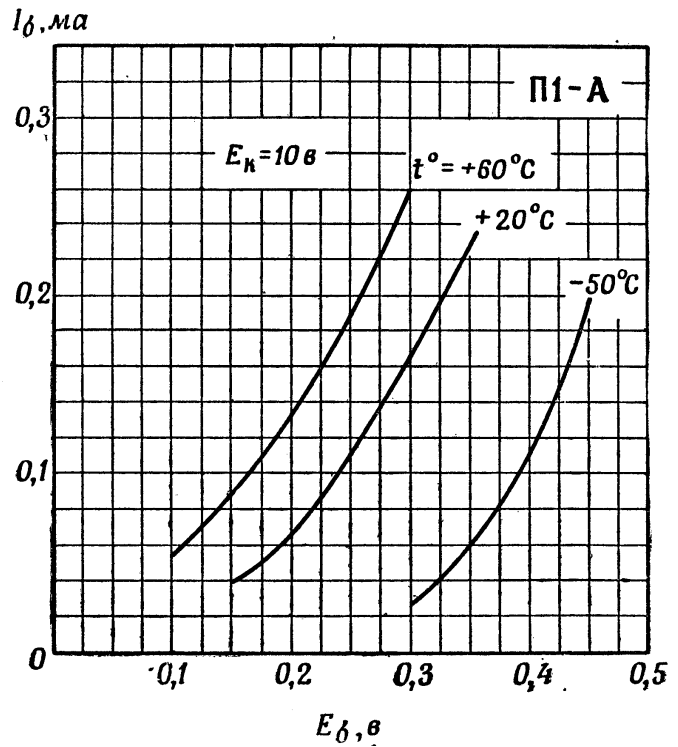
Зависимость коэффициента усиления от частоты



Зависимость обратного тока коллектора от температуры



Зависимость входных характеристик от температуры



Зависимость h-параметров от температуры

